

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年1月5日(2012.1.5)

【公開番号】特開2009-33159(P2009-33159A)

【公開日】平成21年2月12日(2009.2.12)

【年通号数】公開・登録公報2009-006

【出願番号】特願2008-184841(P2008-184841)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

B 24 B 37/12 (2012.01)

B 24 B 37/00 (2012.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 2 1 B

B 24 B 37/04 X

B 24 B 37/00 H

H 01 L 21/304 6 2 1 D

H 01 L 21/304 6 2 2 X

【誤訳訂正書】

【提出日】平成23年11月14日(2011.11.14)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体材料から構成された基板を研磨する方法において、

研磨パッド中に結合された研磨材を含有する研磨パッド上で基板を研磨し、固体を含有しない研磨剤溶液が研磨工程中に基板と研磨パッドとの間に導入される、タイプAの少なくとも1つの研磨工程；

研磨パッド中に結合された研磨材を含有する研磨パッド上で基板を研磨し、結合されていない研磨材を含有する研磨剤スラリーが研磨工程中に基板と研磨パッドとの間に導入される、タイプBの少なくとも1つの研磨工程；および

基板を研磨材が結合されていない研磨パッドを用いて研磨し、結合されていない研磨材を含有する研磨剤スラリーを、研磨工程中に基板と研磨パッドとの間に導入するタイプCの少なくとも1つの研磨工程を有し、

タイプAの研磨工程およびタイプBの研磨工程と同じ研磨板上で実施し、タイプBの研磨工程をタイプAの研磨工程の前または後に実施することを特徴とする、半導体材料から構成された基板を研磨する方法。

【請求項2】

タイプAの研磨工程およびタイプBの研磨工程を異なる研磨板上で実施する、請求項1記載の方法。

【請求項3】

研磨剤スラリーは、元素のアルミニウム、セリウムまたはケイ素の1つ以上の酸化物を研磨材として含有する、請求項1又は2記載の方法。

【請求項4】

研磨材スラリーは、0.25～20質量%の固体量を有する、請求項3記載の方法。

【請求項5】

研磨材スラリーは酸化剤を含有し、基板はゲルマニウムを有するかまたはゲルマニウムを含有する、請求項3又は4記載の方法。

【請求項6】

固体を含有しない研磨剤溶液は酸化剤を含有し、基板はゲルマニウムを有するかまたはゲルマニウムを含有する、請求項1記載の方法。

【請求項7】

清浄剤を研磨パッド上に開放気泡フォーム体を利用して分布させることにより、研磨パッドを研磨工程中に清浄化する、請求項1から6までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項8】

基板を、タイプAまたはタイプBの研磨工程後、またはこれら双方の研磨工程後にエッティングするかまたは清浄化する、請求項1から7までのいずれか1項に記載の方法。